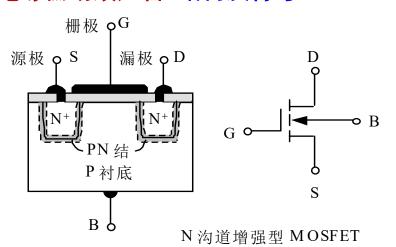
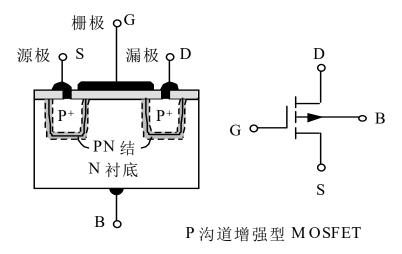
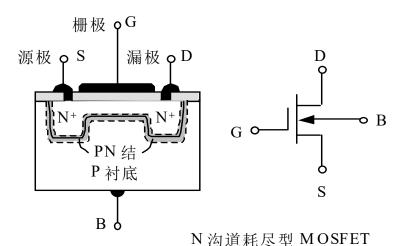
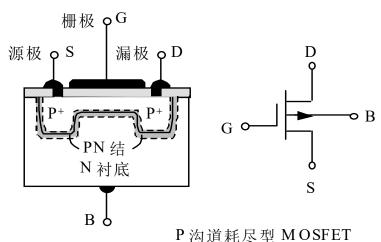


- 3.1 场效应管工作原理(先讲N沟道,再扩展到P沟道)
- 2 绝缘栅场效应管-结构及符号



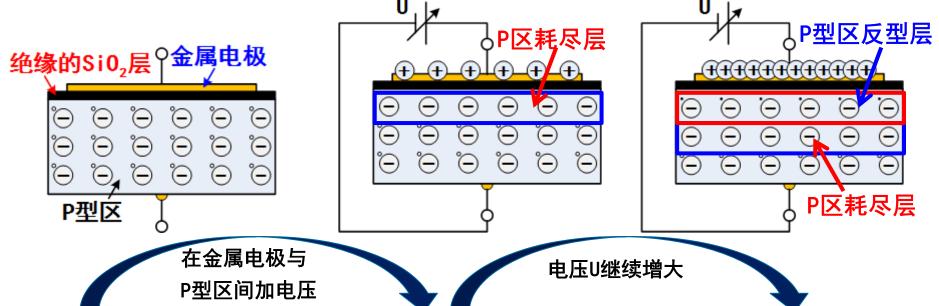








- 3.1 场效应管工作原理(先讲N沟道,再扩展到P沟道)
- 2 绝缘栅场效应管-N沟道增强型MOSFET概念

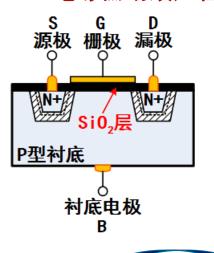


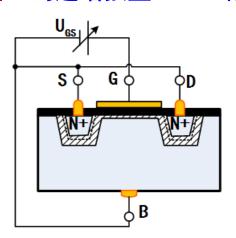
原始状态

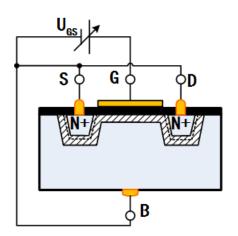
当U增大时, P型区贴 近SiO₂的薄层将形成 P型区耗尽层。 当U继续增大到某值时,P型区贴近SiO<sub>2</sub>的薄层开始形成P型区反型层,P型区 贴近P型区反型层仍然存在P型区耗尽层; P型区反型层刚刚开始形成时的电压U称 为开启电压。

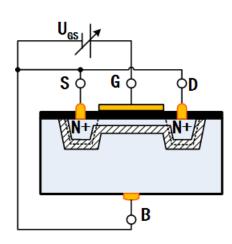


- 3.1 场效应管工作原理(先讲N沟道,再扩展到P沟道)
- 2 绝缘栅场效应管-N沟道增强型MOSFET概念









在G极与短接的S、

D、B极间加电压

电压Ugs继续增大

电压U<sub>gs</sub>继续增大

原始状态

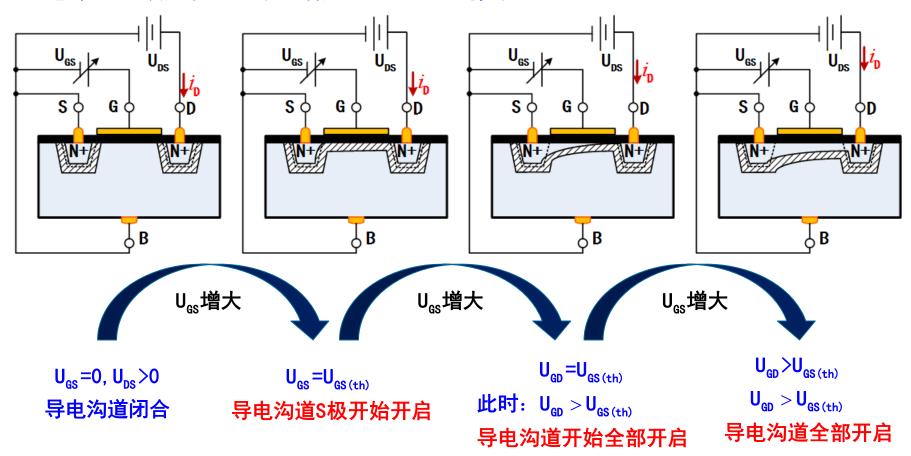
当U<sub>gs</sub>增大时,P型区 贴近SiO<sub>2</sub>的薄层将形 成P型区耗尽层。

当U<sub>ss</sub>继续增大到某值时,P型区 贴近SiO<sub>2</sub>的薄层将开始形成P型 区反型层,P型区贴近P型区反型 层仍然存在P型区耗尽层,P型区 反型层刚刚开始形成时的电压U为 开启电压,记为U<sub>gs(th)</sub>。

P型区反型层 构成的导电沟 道将继续变宽

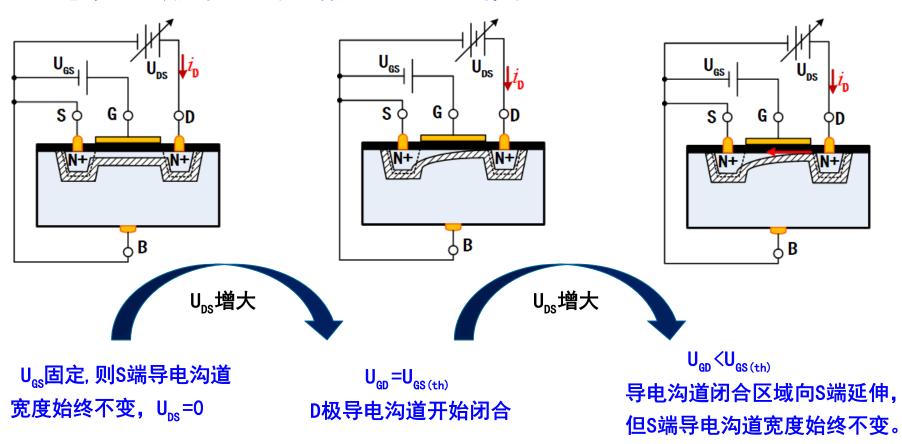


- 3.1 场效应管工作原理(先讲N沟道,再扩展到P沟道)
- 2 绝缘栅场效应管-N沟道增强型MOSFET工作原理





- 3.1 场效应管工作原理(先讲N沟道,再扩展到P沟道)
- 2 绝缘栅场效应管-N沟道增强型MOSFET工作原理





#### 场效应管的工作原理

- 场效应管工作原理(先讲N沟道,再扩展到P沟道)
- 2 绝缘栅场效应管-N沟道增强型MOSFET特性曲线
- I 转移特性曲线:  $i_D = f(u_{GS})|_{U_{DS} = \mathbb{E}_{\mathbf{G}}}$  (恒流区) II 输出特性曲线:  $i_D = f(u_{DS})|_{U_{DS} = \mathbb{E}_{\mathbf{G}}}$

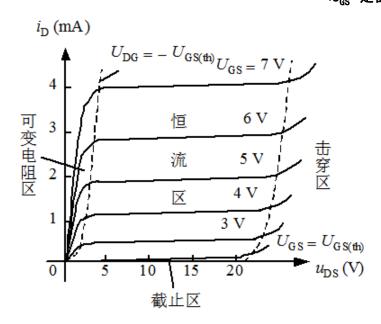
 $i_{\rm D}$  (mA) 3 2  $U_{\rm GS(th)}$ 0

$$i_{\rm D} = \frac{\mu_{\rm n} C_{\rm ox}}{2} \frac{W}{L} (u_{\rm GS} - U_{\rm GS(th)})^2$$

μ,为沟道自由电子运动的迁移率;

 $C_{ox}$ 为单位面积的栅极电容;

W和L分别是导电沟道的宽度和长度。



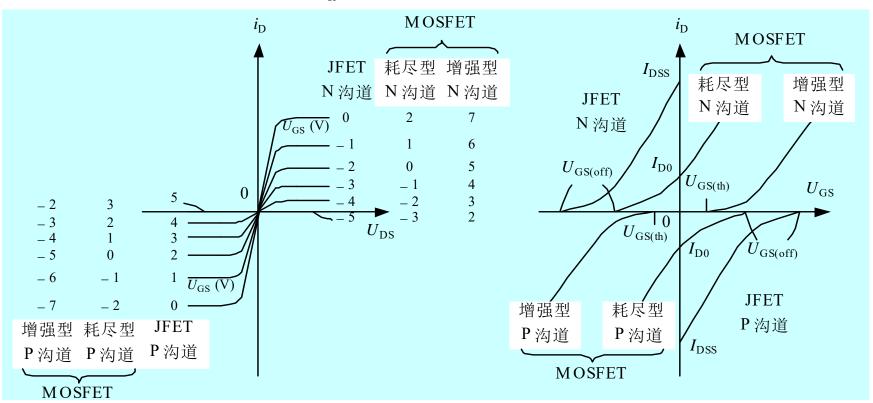
注意:厄尔利电压,记为U<sub>A</sub>

沟道调制系数 
$$\lambda = \frac{1}{|U_A|}$$



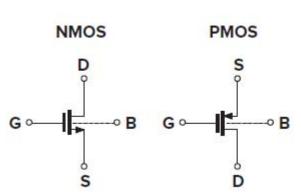
- 3.1 场效应管工作原理
- 4 P沟道场效应管- 特性曲线
  - I 输出特性曲线:  $i_D = f(u_{DS})|_{U_{GS} = \mathbb{Z}_d}$

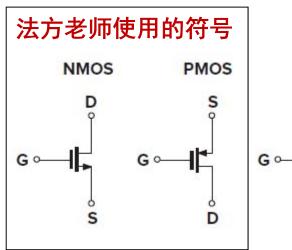
II 转移特性曲线:  $i_D = f(u_{GS})|_{U_{DS} = \mathbb{E}_{d}}$ 

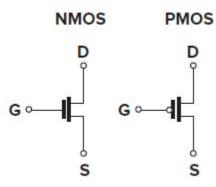




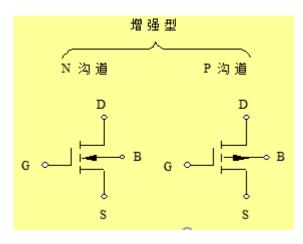
- 3.1 场效应管工作原理(先讲N沟道,再扩展到P沟道)
- 4 增强型场效应管- 电路符号对比







国内教材使用的符号





#### 3.2 判断场效应管的工作状态

以N沟道为例

注意: P沟道时将不等号反向



直流通路:提供合适的直流工作状态,使Q点位于

基本放大器构成 放大区或恒流区的中心。

交流通路: 实现对交流信号的放大。

直流分析: 1. 画直流通路(方法: 交流信号置零、电容开路、电感短路)

2. 分析 {解析分析 } 其目的: 确定直流工作点,即Q点

基本放大器分析。

交流分析: 1. 画交流通路(方法:直流信号置零、电容短路、电感开路)

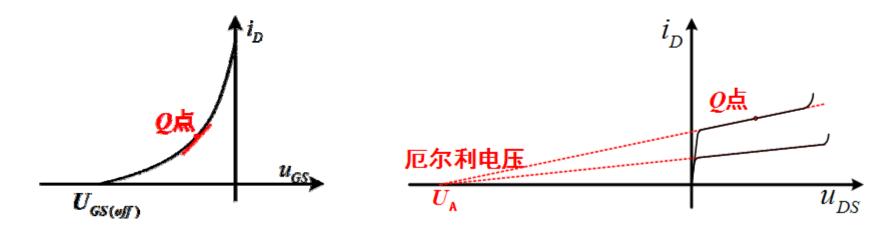
2. 分析 解析分析: 计算性能指标 图解分析: 确定动态范围



#### 5.1 场效应管的低频小信号模型(六类场效应的模型都一样)

转移特性曲线

输出特性曲线



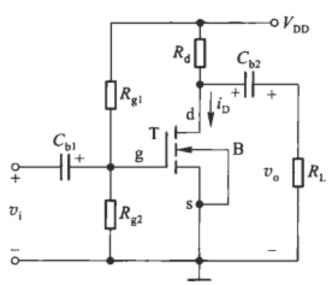
$$g_{m} = \frac{i_{d}}{u_{gs}} = \frac{\partial i_{D}}{\partial u_{GS}} \Big|_{Q} = \frac{\partial u_{DS}}{\partial u_{gs}} \Big|_{Q} = \frac{\partial$$



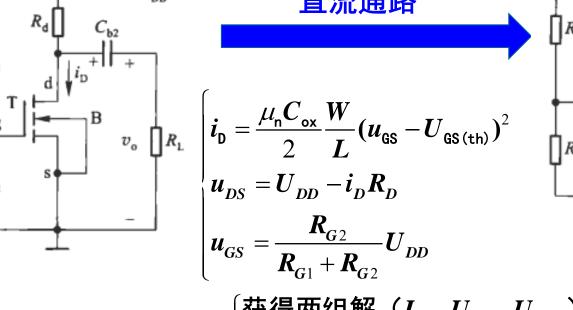
#### 场效应管放大器分析

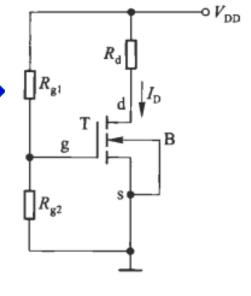
5.2 直流解析分析(已知:电流方程,目的:计算 $I_{DO}$ 、 $U_{GSO}$ 、 $U_{DSO}$ )

例5.1 电路如图所示,对其作直流解析分析。



#### 直流通路





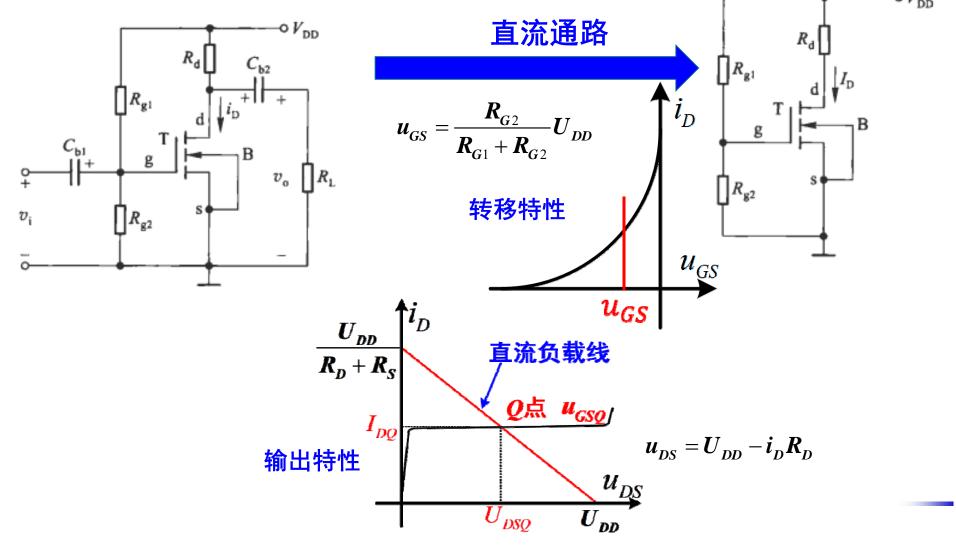
分压式偏置电路

$$\Rightarrow egin{cases} ar{x}$$
得两组解( $I_{DQ}, U_{GSQ}, U_{DSQ}$ ), $egin{cases} ar{x} U_{GSQ} < U_{GS(off)} \end{pmatrix}$ 的解



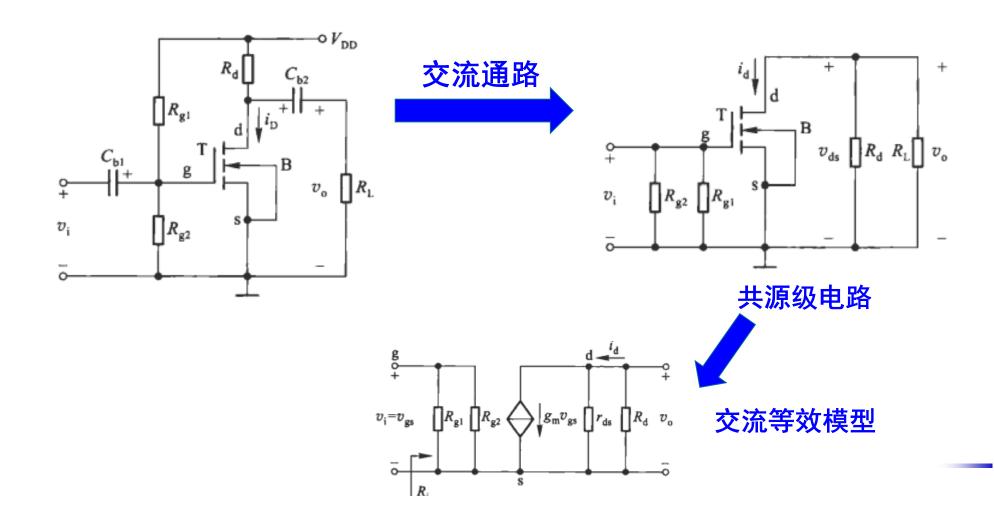
5.3 直流图解分析(已知:转移特性和输出特性,目的:确定Q点)

例5.2 电路如图所示,对其作直流图解分析。





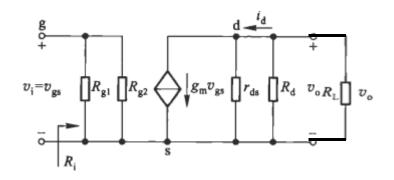
- 5.3 交流解析分析(已知: g<sub>m</sub>, 目的: 计算A<sub>u</sub>、R<sub>i</sub>、R<sub>o</sub>)
- 例5.3 电路如图所示,对其作交流解析分析。





5. 3 交流解析分析(已知: g<sub>m</sub>, 目的: 计算A<sub>u</sub>、R<sub>i</sub>、R<sub>o</sub>)

例5.3 电路如图所示,对其作交流解析分析。



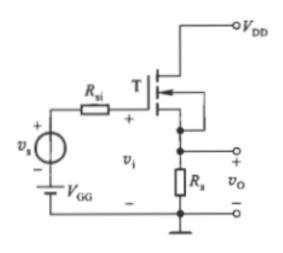
$$A_{u} = \frac{u_{o}}{u_{i}} = \frac{-g_{m}u_{gs}(r_{ds} / /R_{d} / /R_{L})}{u_{gs}} = -g_{m}(r_{ds} / /R_{d} / /R_{L})$$

$$\mathbf{R}_{i} = \frac{\mathbf{u}_{i}}{\mathbf{i}_{i}} = \mathbf{R}_{g1} / / \mathbf{R}_{g2}$$

$$R_o = \frac{u_o}{i_o}\bigg|_{u_s=0,R_L\to\infty} = r_{ds} / R_d$$

5. 3 交流解析分析(已知: g<sub>m</sub>, 目的: 计算A<sub>u</sub>、R<sub>i</sub>、R<sub>o</sub>)

例5.4 电路如图所示,对其作交流解析分析。



共漏级电路

$$A_{u} = \frac{u_{o}}{u_{i}} = \frac{g_{m} (r_{ds} / /R_{s} / /R_{L})}{1 + g_{m} (r_{ds} / /R_{s} / /R_{L})}$$

$$R_{i} = \frac{u_{i}}{i_{i}} = \infty$$

$$R_{o} = \frac{u_{o}}{i_{o}} \Big|_{u=0} = \frac{1}{g_{m}} / /r_{ds} / /R_{s}$$



5.3 交流解析分析(已知: g<sub>m</sub>, 目的: 计算A<sub>n</sub>、R<sub>i</sub>、R<sub>o</sub>)

例5.5 电路如图所示,对其作交流解析分析。

